**Załącznik 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych (wafers) wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

1. GaAs N-type 3” 100 sztuk

2. GaAs N-type 4” (100 mm) 100 sztuk

3. GaAs N-type 6” (150 mm) 50 sztuk

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

1. **Kryteria**

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| Cena (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

* Pi – cena towarów wraz z dostawą - dla danej przedłożonej oferty
* Pmin - minimalna cena dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert
* S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

1. **Termin wykonania zamówienia**

Do 7 tygodni od daty zamówienia.

1. **Parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| **GaAs N-type**  | Średnica 3” Grubość: 625±25 µmŚrednica: 76.2±0.1 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Domieszka | Si |
| Orientatcja: | (100)±0.1o |
| Średnica 4”Grubość: 675±25 µmŚrednica: 100±0.1 mm | Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±1o |
| Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±2o |
| Koncentracja nośników.: | 0.8-4E18/cm3 |
| Średnica 6”Grubość: 675±25 µmŚrednica: 150±0.1 mm | EPD (średnia): | 500/cm2 max |
| TTV: | 5 micr. max |
| TIR: | 4 micr. max |
| wykrzywienie: | 10 micr. max |
| Off-orientation | No miscut |
| Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowana |
| Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |